Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0302U005084

Державний реєстраційний номер: 0101U002474

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-02-2002

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка технічного завдання. Дослідження впливу рекомбінаційно-стимульованої дифузії та релаксаційних процесів на розподіл домішок в збуджених та незбуджених електричним струмом кристалах з дислокаціями

Початок етапу: 01.2001

Закінчення етапу: 12.2001

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2661468

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР:

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дефекти структури та їх вплив на оптичні, механічні і електрофізичні властивості напівпровідників

Назва роботи англійською:

Stuctural defects and their influence on optical, mechanical and electrophysical properties of semiconductors

Реферат українською:

Рентгено-дифрактометричним методом встановлена найбільш вірогідна фізична природа процесів старіння дислокацій в кристалах. Вивчена індукована електричним струмом рекомбінаційно-стимульована дифузія домішок та стимульована електричним полем перезарядка домішок в кремнії. Показано, що збудження електронної підсистеми приводить до зміни зарядового стану поверхні та площин ковзання дислокацій. Це змінює електрофізичні властивості кристалів.

Реферат англійською:

The most probable physical nature of the processes of dislocations aging has been determenited using the X-ray diffraction method. The recombi-nationally-stimulated by the electric current diffusion of the impurities in silicon as well as the stimulated by electric field recharging of the impurities have been studied. Excitation of the electron subsystem was shown to cause the change both of charge state both of surfase and dislocation glide plane. This leads to crystals electrophysical properties changing.

Індекс УДК: 548.571;548.4, 548.4

Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Макара В.А.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Дефекти структури та їх вплив на оптичні, механічні і електрофізичні властивості напівпровідників.: звіт про НДР (проміжний)/ КУ- Київ, 2001,70 с.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Гондюл В.П.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

